

E3

PRAKTIČKÁ MĚŘENÍ - SEZNAM ÚLOH - školní rok 2024/2025

ÚLOHA	POZNÁMKA
<p>Úvodní cvičení:</p> <ol style="list-style-type: none">1. hodina: laboratorní řád, zpracování a vyhodnocování výsledků měření2. hodina: regulace napětí a proudu3. hodina: měření napětí a proudů	
<ol style="list-style-type: none">1. Chyby měřících přístrojů - kontrola V a A2. Měření odporů - Ohmova metoda3. Měření odporů - srovnávací metoda4. Měření odporů - Wheatstonův můstek	
<ol style="list-style-type: none">5. Měření odporů - Thomsonův můstek6. Měření indukčnosti - Ohmova metoda7. Měření impedance - indukčnost s jádrem8. Měření frekvence a fázového posunu	
<p>Praktické přezkoušení I</p> <ol style="list-style-type: none">9. Měření indukčnosti a kapacity - rezonanční metoda10. Měření kapacity - Ohmova metodou a Scheringův můstek11. Měření na elektrických strojích a přístrojích - transformátor I a II12. Měření výkonu ve střídavé 3.f. soustavě - metoda dvou wattmetrů	
<ol style="list-style-type: none">13. Měření jalového výkonu - Görgessův můstek14. Magnetická měření – měření ztrát ve feromagnetiku15. Měření parametrů polovodičových prvků - dioda16. Návrh a měření parametrického stabilizátoru se ZD	
<p>Praktické přezkoušení II</p> <ol style="list-style-type: none">17. Měření parametrů polovodičových prvků - diak18. Měření parametrů polovodičových prvků - bipolární tranzistor19. Měření parametrů polovodičových prvků - unipolární tranzistor20. Měření parametrů polovodičových prvků - otron	
<ol style="list-style-type: none">21. Měření parametrů polovodičových prvků - hradlo TTL I22. Měření parametrů polovodičových prvků - hradlo TTL II23. Měření parametrů polovodičových prvků - fotoprvky24. Měření parametrů polovodičových prvků - MOSFET	
<p>Praktické přezkoušení III</p>	

Absolvování praktických přezkoušení je podmínkou klasifikace